

650V N-Channel VDMOS
使用及贮存时需防静电
符合 RoHS 等环保指令要求

1. 主要用途

主要用于充电器、LED驱动、电源
适配器等各类功率开关电路

2. 主要特点

- 开关速度快
- 通态电阻小，输入电容小

3. 封装外形

TO-251S/TO-252S

4. 电特性

4.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25$

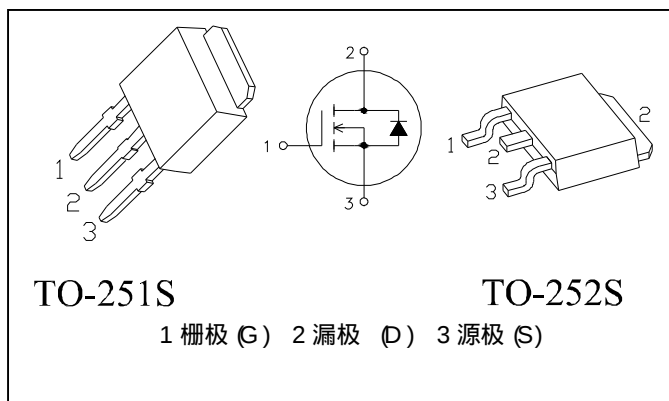
参 数 名 称	符号	额定值	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	650	V
连续漏极电流	I_D	7	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	28	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	350	mJ
热阻（结到壳）	$R_{\theta JC}$	1.92	/W
耗散功率($T_a=25$)	P_{tot}	65	W
结温	T_j	150	
贮存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	

4.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650			V
通态电阻	$R_{DS(on)}^*$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$		1.2	1.4	Ω
阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2		4	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V$			± 100	nA
源漏二极管正向压降	V_{SD}^*	$I_S=7A, V_{GS}=0V$			1.5	V
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$ $f=1.0MHz$		1130		pF
输出电容	C_{oss}			93		pF
反向传输电容	C_{rss}			5.5		pF

* 脉冲测试： $t_p \leq 300\mu s, \delta \leq 2\%$
* $L=10mH, I_D=7A, T_j=25$



4 特性曲线

图 1 安全工作区 (直流)

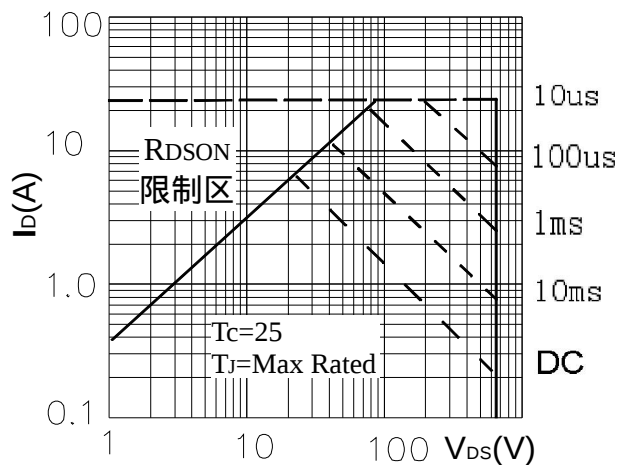


图 2 P_{tot} -T 关系曲线

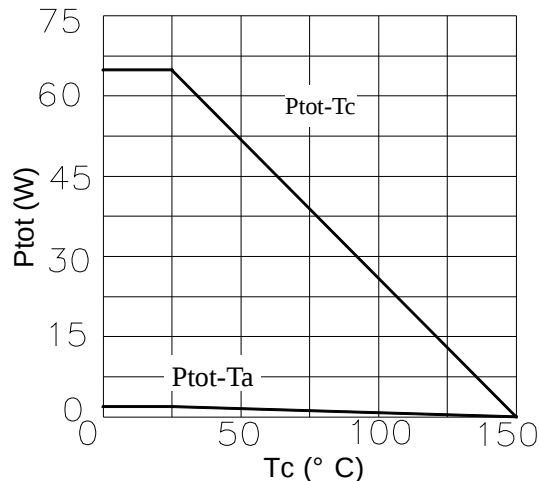


图 3 传输特性曲线

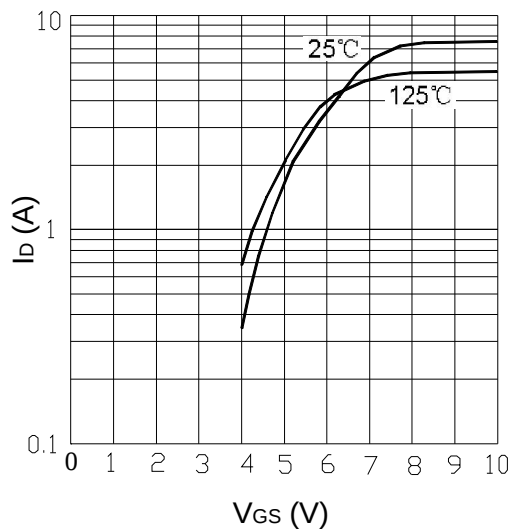


图 4 通态电阻-温度关系曲线

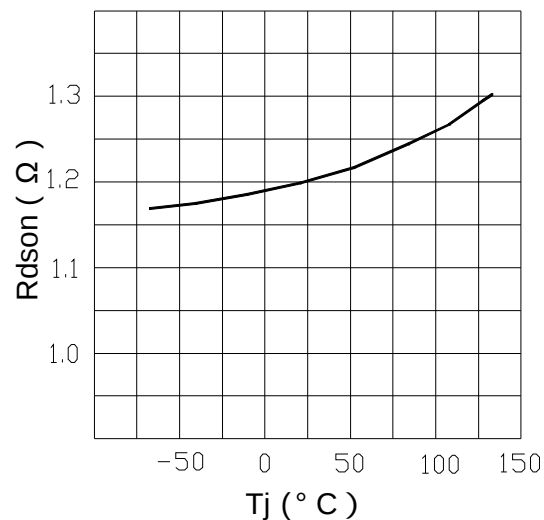


图 5 击穿电压-温度关系曲线

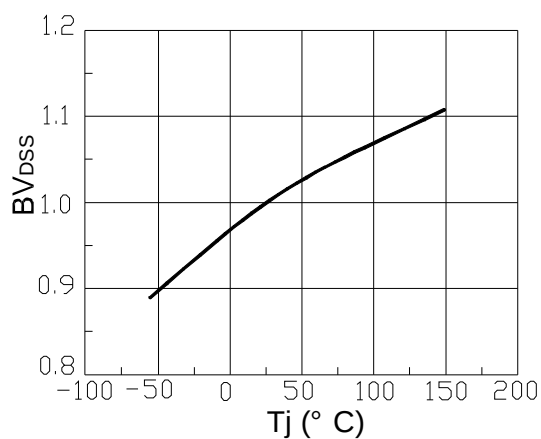
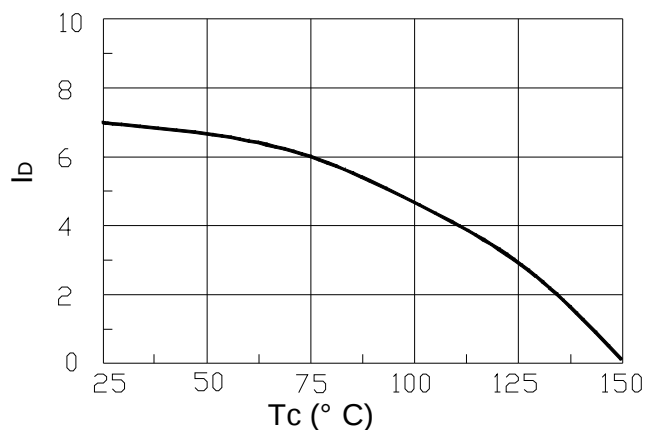
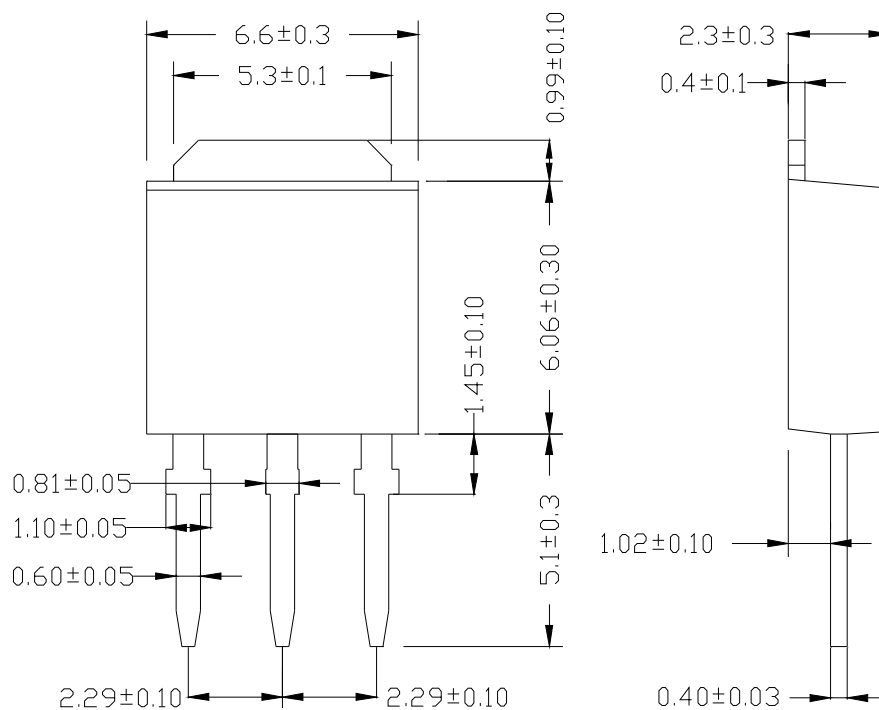


图 6 漏极电流-温度关系曲线



6. 产品外形尺寸图 (单位：mm)

TO-251S



TO-252S

